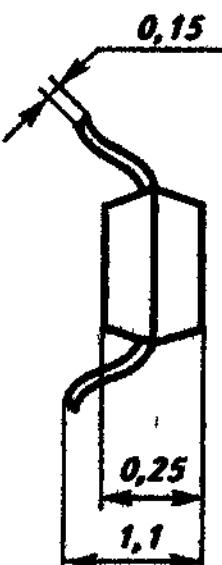
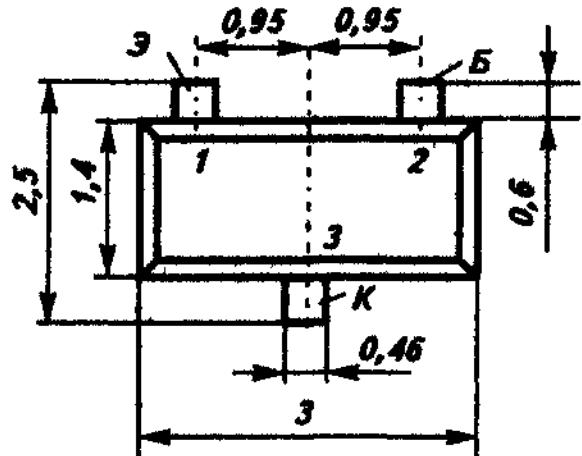


□ KT3170A9



Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* усиительный. Предназначен для применения в выходных каскадах УПЧ телевизоров и в бытовой видеотехнике в составе гибридных интегральных микросхем. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 0,01 г.

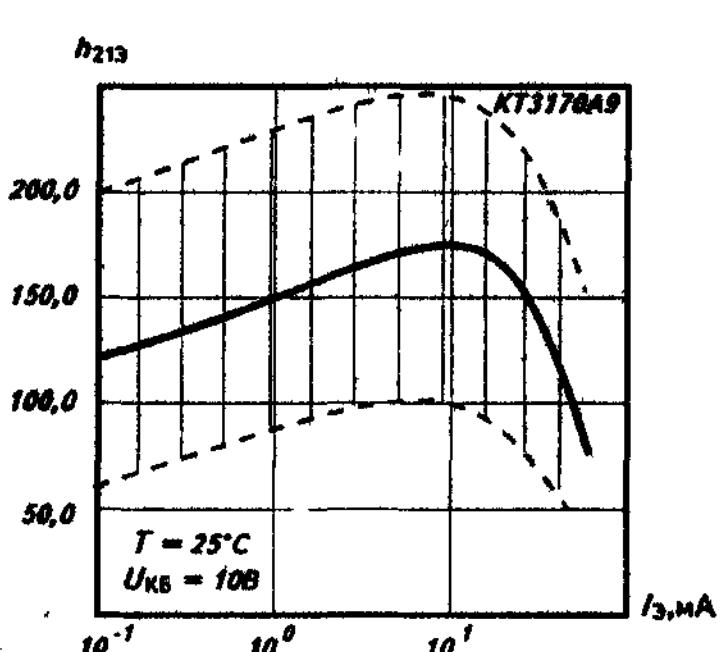
KT3170A9

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\text{КБ}} = 10$ В, $I_{\text{Э}} = 7$ мА,	не менее	100
Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\text{КБ}} = 10$ В, $I_{\text{Э}} = 5$ мА,	не менее	300 МГц
Границное напряжение при $I_{\text{Э}} = 10$ мА, не менее	30 В	
Емкость коллекторного перехода при $U_{\text{КБ}} = 10$ В, не более	2 пФ	
Обратный ток коллектора, не более:		
при $U_{\text{КБ}} = 20$ В	0,1 мкА	
при $U_{\text{КБ}} = 40$ В	1 мкА	
Обратный ток эмиттера при $U_{\text{ЭБ}} = 4$ В, не более	1 мкА	

Предельные эксплуатационные данные

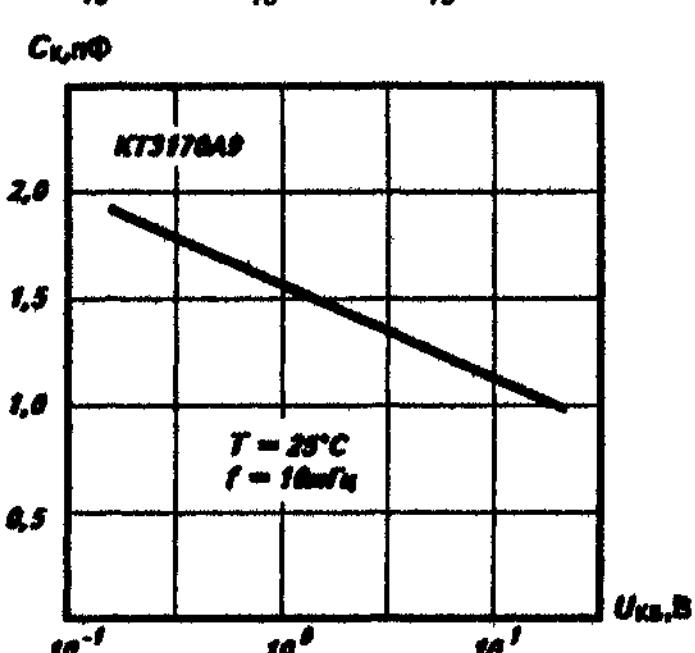
Постоянное напряжение коллектор-база	40 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{\text{БЭ}} = 10$ кОм	30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T = -60 \dots +25^{\circ}\text{C}$	0,25 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150°C
Тепловое сопротивление переход-среда	500°C/Вт
Температура окружающей среды	-60...+100°C



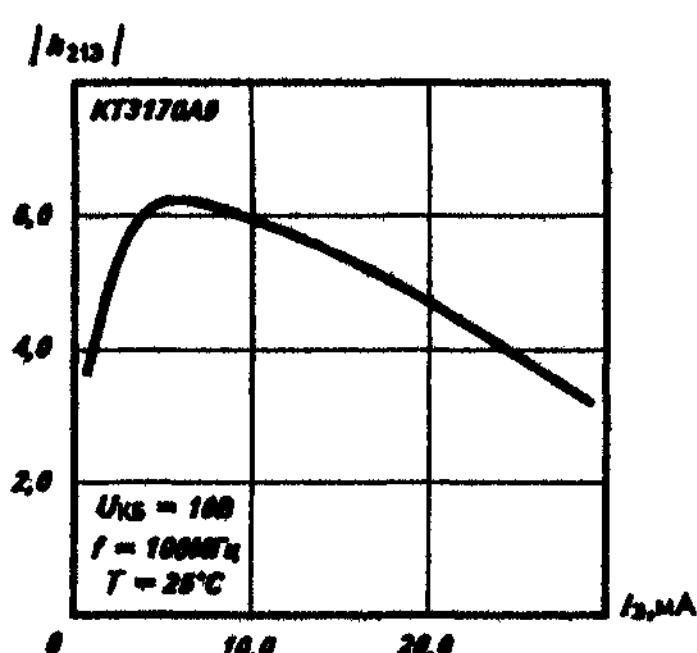
¹ При $T = +25 \dots 100^{\circ}\text{C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{к, макс}} = (150 - T)/500, \text{ Вт}$$

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость емкости коллектора от напряжения коллектора.



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера.